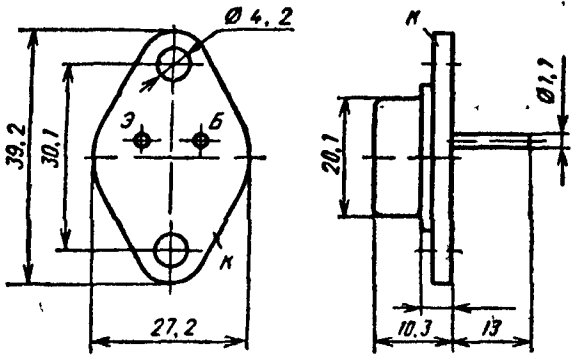


КТ846А



Транзистор кремниевый ме-  
запланарный структуры *n-p-n*  
импульсный. Предназначен для  
применения в блоках горизон-  
тальной развертки телевизоров  
и видеоконтрольных устройств.  
Корпус металлокерамический с  
жесткими выводами. Тип при-  
бора указывается на корпусе.  
Масса транзистора не более  
20 г.

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_K=0,1$ А, $L=40$ мГн, не менее	700 В
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер, не более:	
$T=+25^\circ\text{C}$ , $I_K=4,5$ А, $I_B=2$ А	1 В
$T=-25^\circ\text{C}$ , $I_K=4,5$ А, $I_B=3$ А	2,5 В
$T=+100^\circ\text{C}$ , $I_K=4,5$ А, $I_B=3$ А	1,5 В
Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=4,5$ А, $I_B=2$ А, не более	1,5 В
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ	2*...4*...7* МГц
Время спада при $U_K=500$ В, $I_K=4,5$ А, $I_B=1,8$ А, $U_{БЭ}=5$ В, не более	1* мкс
типичное значение	0,7* мкс
Время рассасывания при $U_K=500$ В, $I_K=4,5$ А, $I_B=1,8$ А, $U_{БЭ}=5$ В, не более	12* мкс
типичное значение	10* мкс
Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{КЭ.н} = 1500$ В, $R_{бэ} = 10$ Ом не более	
$T=+25^\circ\text{C}$	1 мА
$T=-25$ и $+95^\circ\text{C}$	2* мА
Емкость коллекторного перехода	110* 150* 200* пФ

Предельные эксплуатационные данные

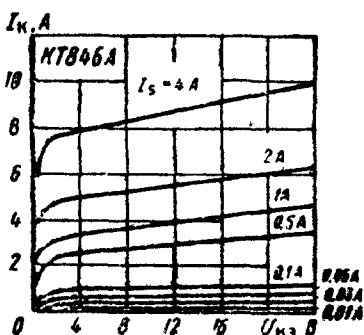
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{бэ} \leq 10$ Ом	1500 В
Импульсное напряжение коллектор — эмиттер <sup>1</sup> при $t_d \geq 2$ мкс	1500 В
Постоянный ток коллектора	5 А
Импульсный ток коллектора	7,5 А
Постоянный запирающий ток базы	0,1 А
Импульсный запирающий ток базы	3,5 А
Импульсный ток базы	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>2</sup> при $T_K = +95^\circ\text{C}$	12,5 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_d \leq 4,5$ мкс, $t_u = 64$ мкс, $T_K = +95^\circ\text{C}$ :	
$U_{КЭ.н} = 150$ В	250 Вт
$U_{КЭ.н} = 200$ В	200 Вт
$U_{КЭ.н} = 300$ В	150 Вт
$U_{КЭ.н} = 400$ В	120 Вт
$U_{КЭ.н} = 600$ В	70 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+115°С
Температура окружающей среды	-25°С... $T_K = +100^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_K = +95...+100^\circ\text{C}$   $U_{КЭ.н, макс}$ ,  $U_{КЭ.н, макс}$  снижаются линейно до 1100 В  
<sup>2</sup> При  $T_K = +95...+100^\circ\text{C}$   $P_{К, макс}$  определяется по формуле

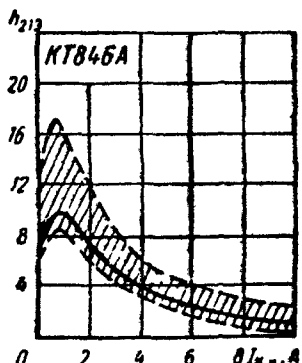
$$P_{К, макс} \text{ Вт} = (T_n - T_K) / R_{Т(n-K)}$$

Допустимое значение статического потенциала 2000 В.

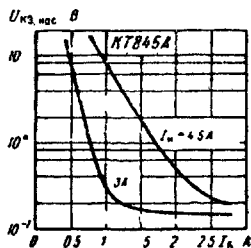
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса при температуре припоя +250°С в течение не более 3 с.



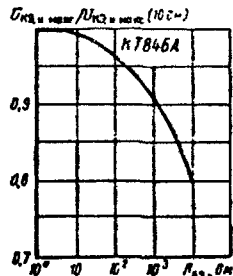
Выходные характеристики



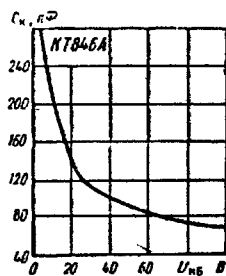
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от импульсного тока коллектора



Зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока базы

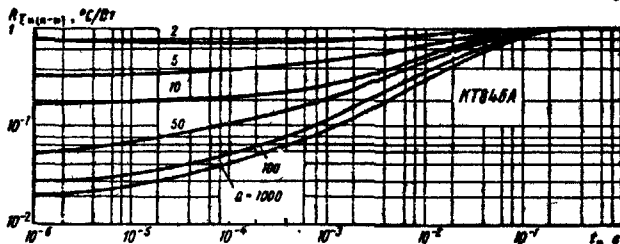
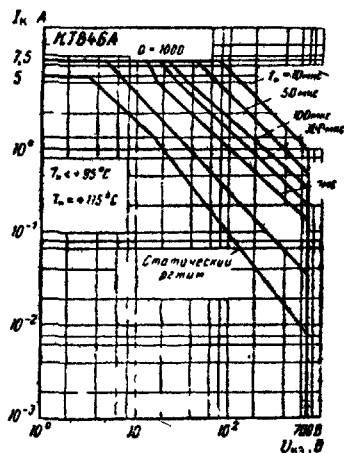


Зависимость максимально допустимого импульсного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база

Области максимальных режимов



Зависимости импульсного теплового сопротивления переход — корпус от длительности импульса